





	<p><b>SI2301BDS-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI2301BDS-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 2.2A SOT23-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI2301BDS-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 68726 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI2301BDS-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 2.2A SOT23-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	68726 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	700mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 2.8A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	950mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	375pF @ 6V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI2301BDS-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI2301BDS-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2301BDS-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2301BDS-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI2301CDS</b> Vishay SI2301CDS Vishay</p>	 <p><b>SI2301CDS-T1-CE3</b> VISHAY VISHAY SOT-23</p>	 <p><b>SI2301CDS-T1</b> VISHAY VISHAY SOT23</p>	 <p><b>SI2301BDS-T1-ES</b> VISHAY VISHAY SOT23</p>
 <p><b>SI2301BDS-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 2.2A SOT23-3</p>	 <p><b>SI2301BDS-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 2.2A SOT23-3</p>	 <p><b>SI2301BDS-T1-E3</b> Vishay Precision Group SI2301BDS-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI2301BDS-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 2.2A SOT23-3</p>

heiße Teile

Mehr

- |  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  SI2176-B30-GMR   |  SI2176-B30-ZM7R  |  SI2176-B30-ZM8R  |  SI2178-A20-GMR   |  SI2191-A20-ZM7R  |
|  SI2196-A0A-GMR   |  SI2300/AE9T      |  SI2300BDS-T1-GE3 |  SI2300DS         |  SI2300DS-T1      |
|  SI2300DS-T1-E3   |  SI2300DS-T1-GE3  |  SI2300DS-T1-GE3  |  SI2300DS-TI-E3   |  SI2301-TP        |
|  SI2301A1SHB      |  SI2301ADS        |  SI2301ADS-T1-E3  |  SI2301ADS-T1-GE3 |  SI2301BDS        |
|  SI2301BDS-E3     |  SI2301BDS-T1     |  SI2301BDS-T1-E3  |  SI2301BDS-T1-E3  |  SI2301BDS-T1-GE3 |
|  SI2301CDS        |  SI2301CDS-T1-E3  |  SI2301CDS-T1-E3  |  SI2301CDS-T1-GE3 |  SI2301CDS-T1-GE3 |
|  SI2301DS         |  SI2301DS-E3      |  SI2301DS-T1      |  SI2301DS-T1-E3   |  SI2301DS-T1-GE3  |
|  SI2302ADS        |  SI2302ADS-T1     |  SI2302ADS-T1     |  SI2302ADS-T1-E3  |  SI2302ADS-T1-E3  |
|  SI2302ADS-T1-GE3 |  SI2302ADS-T1-GE3 |  SI2302BDS-T1-E3  |  SI2302CDS-T1-E3  |  SI2302CDS-T1-E3  |
|  SI2302CDS-T1-GE3 |  SI2302CDS-T1-GE3 |  SI2302DDS-T1-GE3 |  SI2302DDS-T1-GE3 |  SI2302DS         |

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited